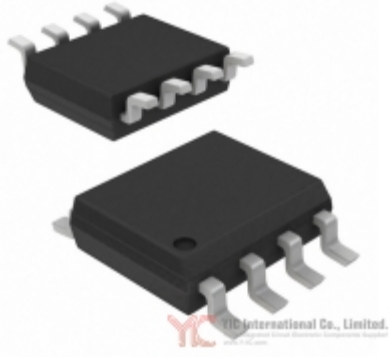









	FDS6673BZ
	Hersteller-Teilenummer: FDS6673BZ
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 14.5A 8-SOIC
Datenblätter:  FDS6673BZ.pdf	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, 56856 pcs Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FDS6673BZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 14.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	56856 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	15 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 14.5A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount 8-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.8 mOhm @ 14.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	124nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4700pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS6673BZDKR

FDS6673BZ ist neu im Original, Suche FDS6673BZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS6673BZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS6673BZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDS6673AZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 14.5A 8SOIC</p>	 <p>FDS6675 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 11A 8-SOIC</p>	 <p>FDS6673BZ-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 14.5A 8-SOIC</p>	 <p>FDS6673BZ-NL FAIRCHI FDS6673BZ-NL FAIRCHI</p>
 <p>FDS6675 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 11A 8-SOIC</p>	 <p>FDS6673AZ-NL FAIRCHILD FAIRCHILD SOP-8</p>	 <p>FDS6673AZ_NL FAIRCHILD FAIRCHILD SOP-8</p>	 <p>FDS6673BZ_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDS6673BZ_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>

heiße Teile

Mehr

 FDS6612A-NL	 FDS6612A_NL	 FDS6614-NL	 D FDS6614A	 FDS6614A
 FDS6614A-NL	 FDS6614AS-NL	 D FDS6630A	 FDS6630A	 FDS6644-NL
 FDS6670-NL	 FDS6670A	 FDS6670A	 FDS6670A-NL	 FDS6670AS
 D FDS6670AS	 FDS6670AS-NL	 FDS6670A_NL	 FDS6670S	 FDS6672A
 FDS6672A	 FDS6672A-NL	 FDS6673AZ	 FDS6673AZ	 FDS6673BZ
 FDS6673BZ_F085	 FDS6675-NL	 D FDS6675A	 FDS6675A	 FDS6675A-NL
 FDS6675BZ	 D FDS6675BZ	 FDS6675BZ-NL	 FDS6676-NL	 FDS6676A-NL
 FDS6676AS	 FDS6676AS	 FDS6676AS-NL	 FDS6676S	 FDS6676S-NL
 FDS6678A-NL	 FDS6679-NL	 FDS6679A	 D FDS6679AZ	 FDS6679AZ
 FDS6679Z	 FDS6679Z	 FDS6679_NL	 FDS6680-NL	 FDS6680A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

